

LN1WBA60

600V 1.1A

特長

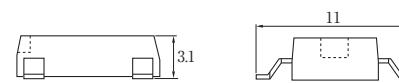
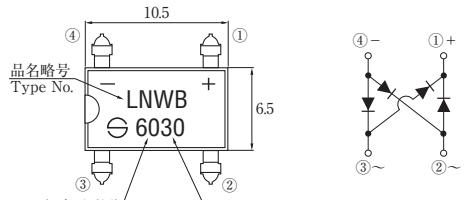
- 低ノイズ
- 小型 DIP パッケージ

Feature

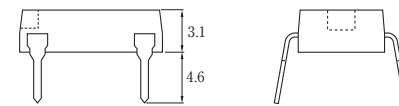
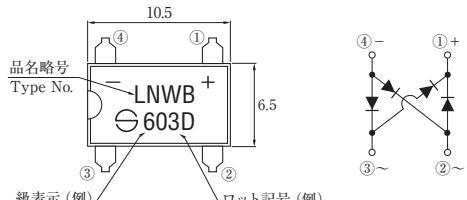
- Low Noise
- Small-DIP

■外観図 OUTLINE

Package : 1W (SMD)

Unit : mm
Weight : 0.46g(typ.)

Package : 1W (THD)

Unit : mm
Weight : 0.46g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

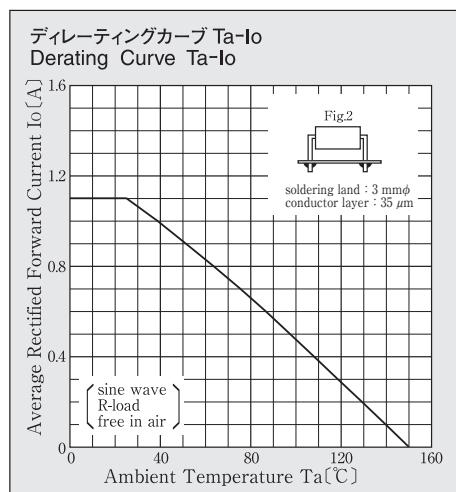
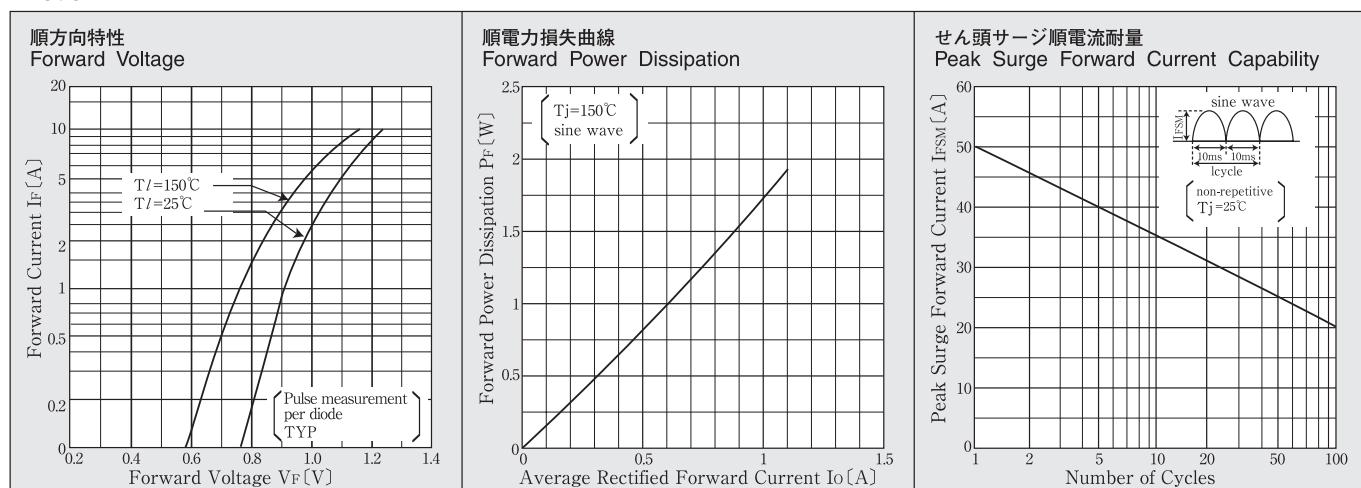
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $TJ = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	LN1WBA60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, Ta=25°C 50Hz sine wave, Resistance load, Ta=25°C		1.1	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, T _j =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T _j =25°C		50	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms ≤ t < 10ms, T _j =25°C, 1 素子当たりの規格値 per diode		6	A ² s

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $TJ = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =0.55A, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.00	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =V _{RM} , パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F =0.1A, I _R =0.1A, 1 素子当たりの規格値 per diode	MAX 5	μs
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 10	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周間間 Junction to Ambient	MAX 65	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.